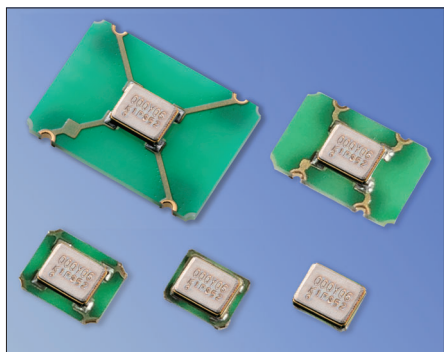




Clock Z系列

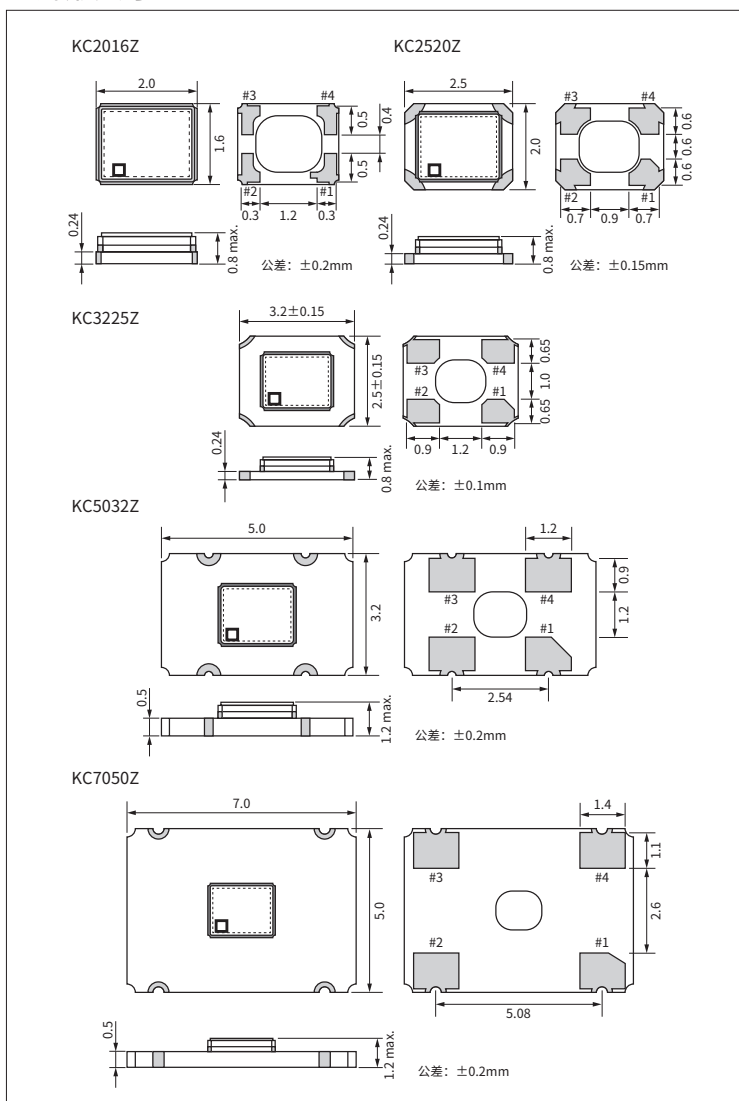
CMOS/ 1.8V、2.5V、3.3V/ 2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm



RoHS指令对应产品

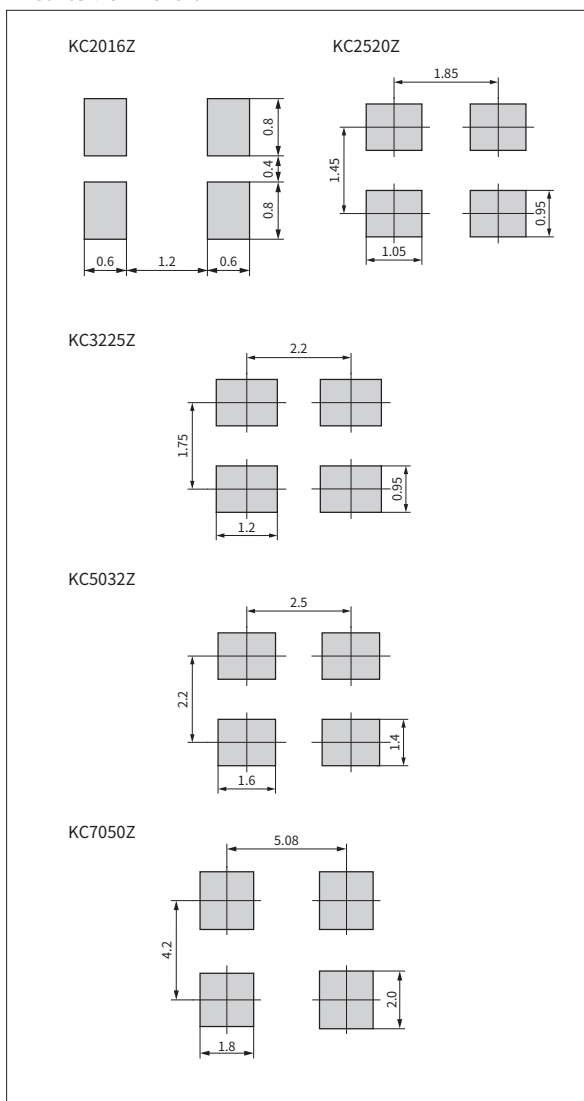
外形尺寸

(单位: mm)



推荐焊盘图案

(单位: mm)



时钟晶体振荡器

焊盘布局

#1	INH
#2	Case GND
#3	Output
#4	Vcc

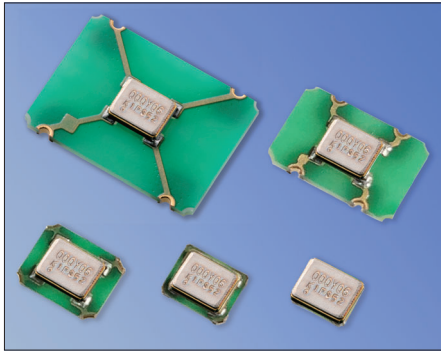
INH功能

Pad1	Pad3 (Output)
Open	Active
"H" Level	Active
"L" Level	High Z (振荡停止)



Clock Z系列“X”类型(标准产品、短交期类型)

CMOS/ 1.8V、2.5V、3.3V/ 2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm



RoHS指令对应产品

■特点

- 可对应频率 0.5~170MHz
- CMOS输出
- 可对应短交期
- 可对应高温(125°C)

■用途

- 消费类电子产品、网络、工业设备、娱乐
- 频率容差(Overall)

容差	工作温度范围(°C)	备注
コード × 10 ⁻⁶		
S ± 30	-10 ~ +70	其他稳定度, 敬请咨询。
U ± 25		
W ± 20		
G ± 50		
H ± 30	-40 ~ +85	
J ± 25		
K ± 20		
L ± 15		
6 ± 50	-40 ~ +105	
5 ± 30		
X ± 100		
Z ± 50	-40 ~ +125	
9 ± 30		

■型号表示方法

KC □□□□ Z 25.0000 C 1 □ X 00
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列名称

KC2016Z	2016型号	KC2520Z	2520型号
KC3225Z	3225型号	KC5032Z	5032型号
KC7050Z	7050型号		

②输出频率(25.0000: 25MHz)

③输出形式(C: CMOS)

④电源电压(1: 可以用于这些规格 1.8V/ 2.5V/ 3.3V)

⑤频率容差(参见左表)

⑥对称/INH功能

X	标准产品 45/ 55%
---	--------------

⑦个别规格(产品目录以00标示)

包装方式 载带包装

KC7050Z/ KC5032Z	1000个/卷盘
KC3225Z/ KC2520Z/ KC2016Z	2000个/卷盘

■规格

项 目	记 号	条 件	Min.	Max.	单 位	
输出频率范围	f _o		0.5	170	MHz	
频率容差	f _{tol}	起始偏差、工作温度范围内的温度特性、电源电压变化、负载容量变化、长期变化(1年@25°C)、包括振动和冲击	参见频率容差表			
储存温度范围	T _{stg}		-55	150	°C	
工作温度范围	T _{use}		参见频率容差表			
最大的额定电压	—		-0.3	4.5	V	
电源电压	V _{cc}		1.71	3.63	V	
电流消耗 (NoLoad/ 1.71≤V _{cc} ≤2.25)	I _{cc}	0.5≤f _o <5MHz	—	5.2	mA	
		5≤f _o <15MHz	—	5.8		
		15≤f _o <30MHz	—	6.2		
		30≤f _o <50MHz	—	6.8		
		50≤f _o ≤60MHz	—	6.8		
		60<f _o <75MHz	—	9		
		75≤f _o <105MHz	—	10		
		105≤f _o <130MHz	—	10.5		
		130≤f _o <160MHz	—	11.5		
		160≤f _o ≤170MHz	—	12.5		
电流消耗 (NoLoad/ 2.25<V _{cc} ≤2.8)	I _{cc}	0.5≤f _o <5MHz	—	5.5	mA	
		5≤f _o <15MHz	—	6		
		15≤f _o <30MHz	—	6.5		
		30≤f _o <50MHz	—	7.2		
		50≤f _o ≤60MHz	—	7.4		
		60<f _o <75MHz	—	10		
		75≤f _o <105MHz	—	11.5		
		105≤f _o <130MHz	—	12.5		
		130≤f _o <160MHz	—	14		
		160≤f _o ≤170MHz	—	15		
电流消耗 (NoLoad/ 2.8<V _{cc} ≤3.63)	I _{cc}	0.5≤f _o <5MHz	—	5.8	mA	
		5≤f _o <15MHz	—	6.5		
		15≤f _o <30MHz	—	7.3		
		30≤f _o <50MHz	—	8		
		50≤f _o ≤60MHz	—	8.5		
		60<f _o <75MHz	—	12.5		
		75≤f _o <105MHz	—	14.5		
		105≤f _o <130MHz	—	15.5		
		130≤f _o <160MHz	—	18		
		160≤f _o ≤170MHz	—	19.5		
待机时的电流消耗	I _{std}		—	5	μA	
波形对称	SYM	@50% V _{cc}	45	55	%	
上升/下降时间 (20%~80% 输出电平)	Tr/ Tf	0.5≤f _o ≤60MHz	Loaded/ 1.71≤V _{cc} ≤2.25	—	4	ns
			Loaded/ 2.25<V _{cc} ≤2.8	—	3	
		60<f _o ≤170MHz	Loaded/ 2.8<V _{cc} ≤3.63	—	2.5	
			Loaded/ 1.71≤V _{cc} ≤2.25	—	1.5	
L电平输出电压	V _{oL}	I _{oL} = 4mA	Loaded/ 2.25<V _{cc} ≤2.8	—	1.3	
			Loaded/ 2.8<V _{cc} ≤3.63	—	1	
			Loaded/ 1.71≤V _{cc} ≤2.25	—	1	
H电平输出电压	V _{oH}	I _{oH} = -4mA	90% V _{cc}	—	V	
输出负载条件(CMOS)	L CMOS		—	15	pF	
L电平输入电压	V _{iL}		—	30% V _{cc}	V	
H电平输入电压	V _{iH}		70% V _{cc}	—	V	
禁用时间	t _{dis}		—	200	ns	
启用时间	t _{ena}		—	5	ms	
振荡启动时间	t _{str}	最小动作电压为0sec.	—	5	ms	

最大负载时, 没有指定条件的电气特性为在工作温度范围内。

